

平成29年度

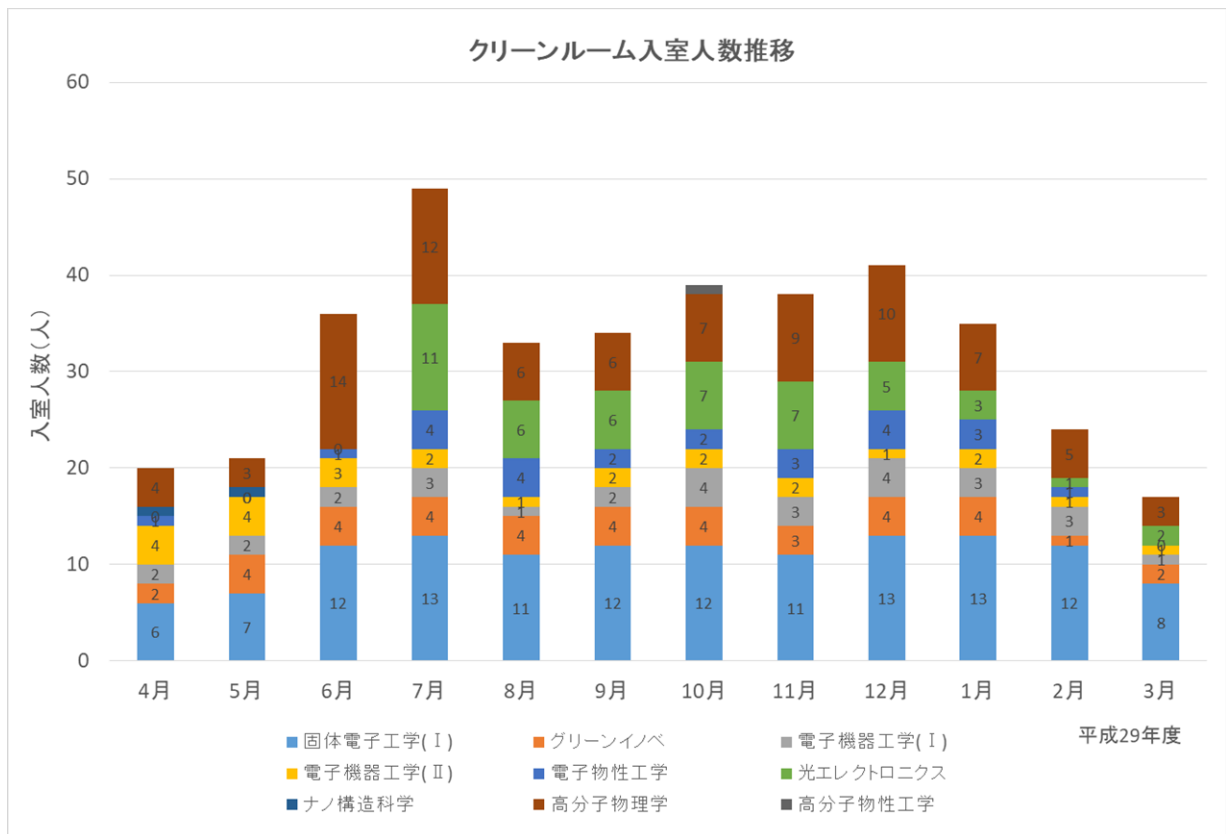
クリーンルーム利用状況

- ・入退室管理システムのデータ解析
- ・機器予約システムのデータ解析

<入退室管理システムのデータ解析>

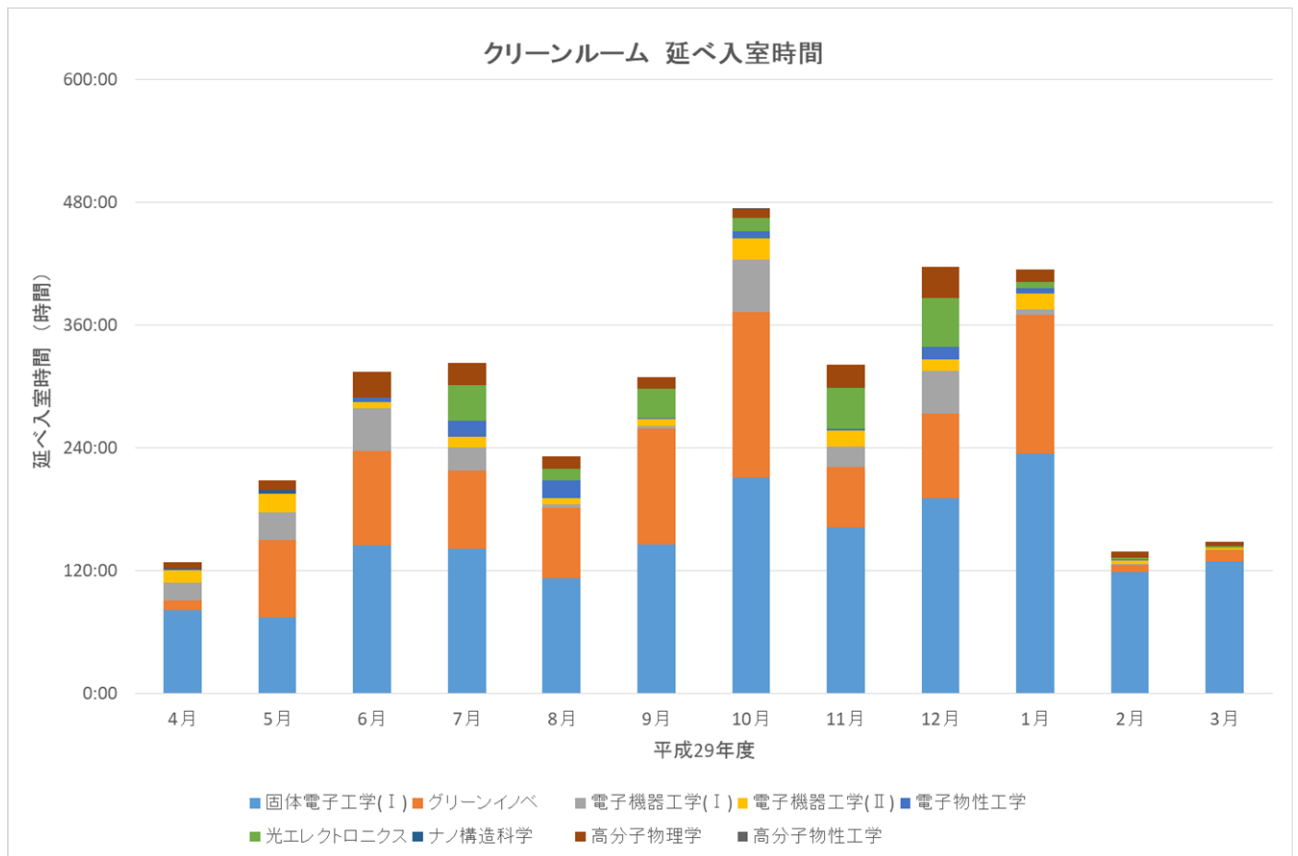
1. 研究室別クリーンルーム入室者数推移

研究室	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
固体電子工学(Ⅰ)	6	7	12	13	11	12	12	11	13	13	12	8
グリーンイノベ	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	1	2
電子機器工学(Ⅰ)	2	2	2	3	1	2	4	3	4	3	3	1
電子機器工学(Ⅱ)	4	4	3	2	1	2	2	2	1	2	1	1
電子物性工学	1	0	1	4	4	2	2	3	4	3	1	0
光エレクトロニクス	0	0	0	11	6	6	7	7	5	3	1	2
ナノ構造科学	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高分子物理学	4	3	14	12	6	6	7	9	10	7	5	3
高分子物性工学	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



2. 研究室別クリーンルーム入室延べ時間推移

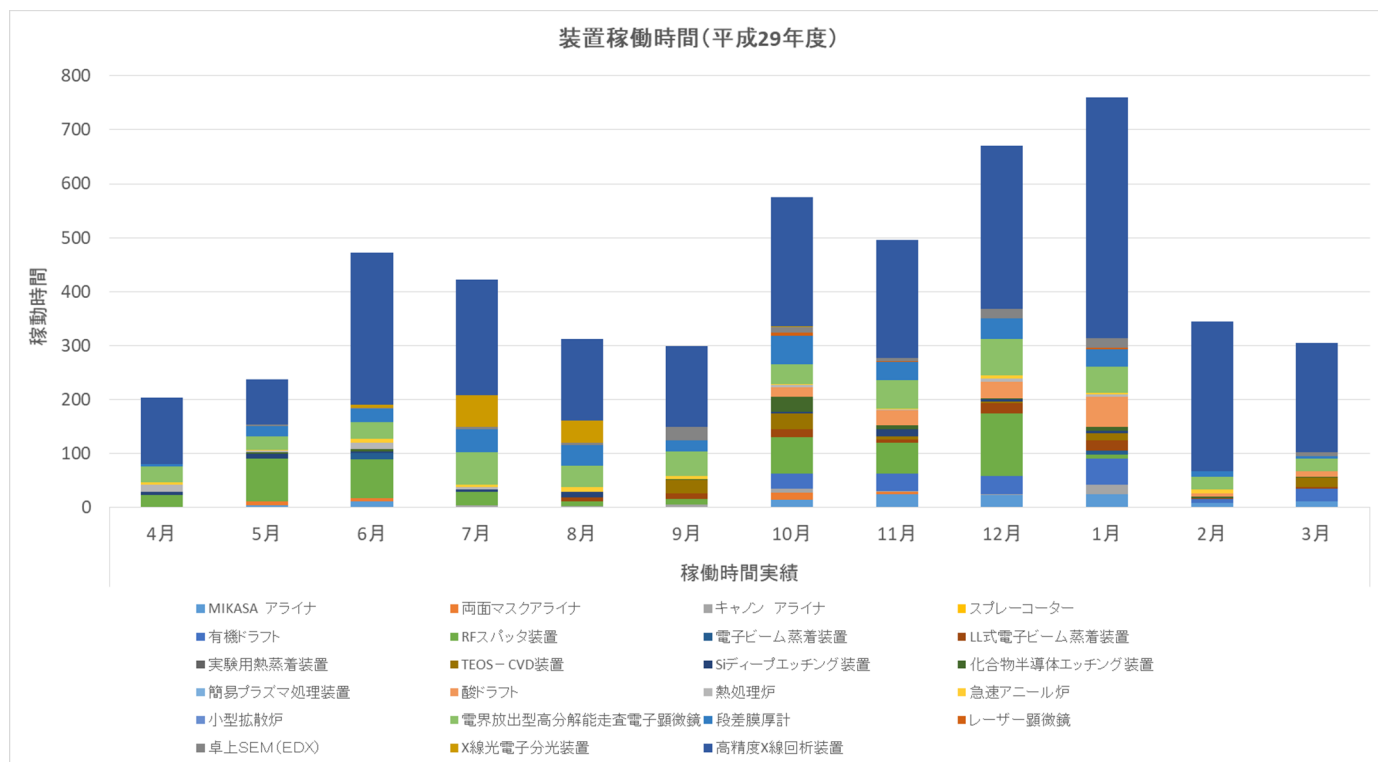
研究室	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
固体電子工学(I)	81:28	74:27	144:36	141:22	112:33	145:34	211:11	162:19	191:17	234:36	118:25	129:21
グリーンイノベ	9:41	75:34	92:34	76:38	68:55	113:39	161:26	59:14	82:39	135:36	7:03	11:03
電子機器工学(I)	17:12	27:19	41:29	22:13	3:48	2:25	51:51	20:11	41:12	5:16	1:12	0:07
電子機器工学(II)	12:25	18:08	6:08	10:25	5:40	6:50	20:10	15:21	11:54	15:45	3:38	1:35
電子物性工学	0:40	0:00	4:05	15:40	17:24	1:00	6:58	1:26	11:33	5:21	0:11	0:00
光エレクトロニクス	0:00	0:00	0:00	35:18	11:38	28:03	13:00	40:30	47:59	5:58	1:47	1:54
ナノ構造科学	0:31	3:07	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
高分子物理学	6:30	9:57	25:29	21:23	11:50	11:39	8:55	22:46	30:23	11:32	6:34	4:38
高分子物性工学	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:37	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00

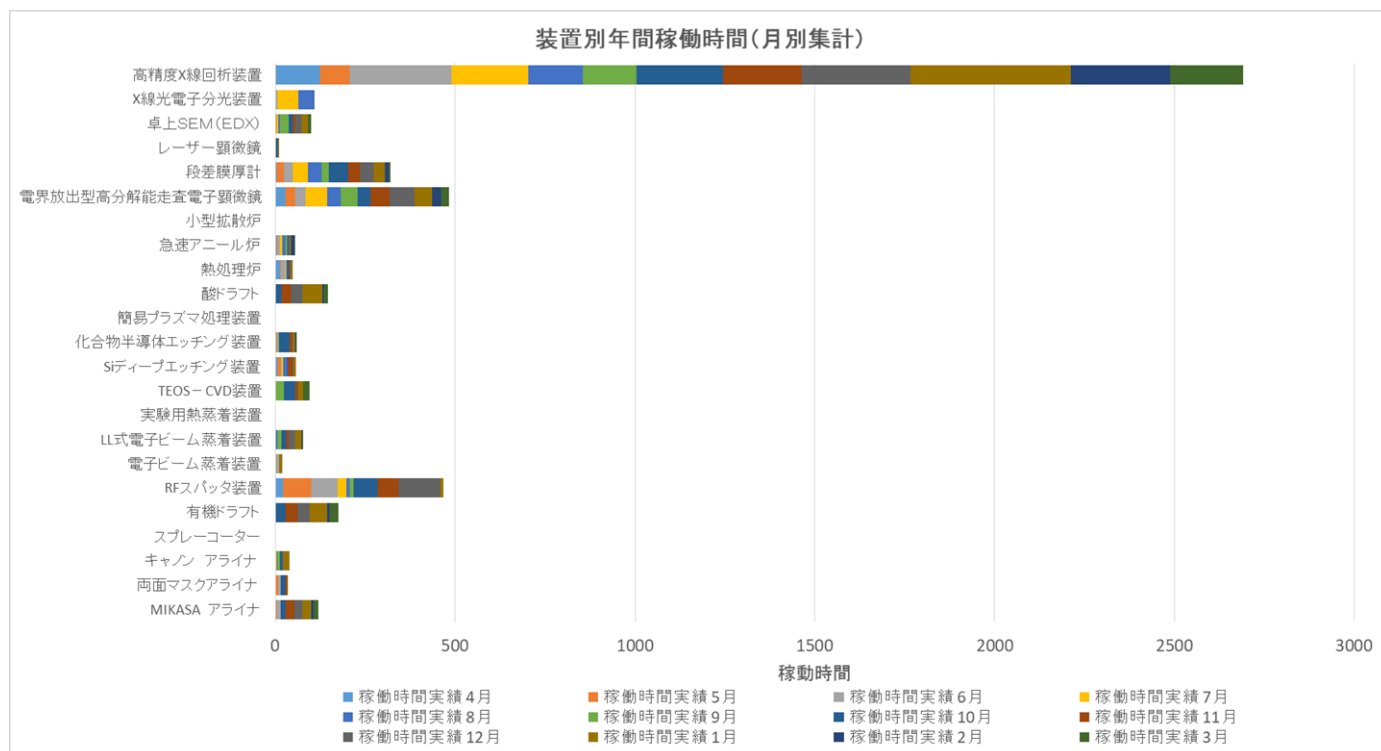


<機器予約システムのデータ解析>

1. 装置稼働時間の推移

装置名	稼働時間実績												年間合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 MIKASA アライナ	0	4	11	0	0	0	14	24	23	24	8	12	119
2 両面マスクアライナ	1	7.5	5.5	1	0	0	13	4.75	1	1	0	0	35
3 キヤノン アライナ	0	0	0	3	3	6	7.5	1	1	17	0	0	38
4 スプレーコーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 有機ドラフト	0	0	0	0	0	0	29	32.9	33	49	8	22	174
6 RFスパッタ装置	22	79	73	25	8.8	10	67	57.5	117	8	0	0	467
7 電子ビーム蒸着装置	0	0	12	0	0	0	0	0	0	7	0	0	19
8 LL式電子ビーム蒸着装置	0	0	0	0	6.5	10	14	5.75	19	19	1.5	3	78
9 実験用熱蒸着装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 TEOS-CVD装置	0	0	0	0	0	25	30	6	2.6	13	0	18	95
11 Siディープエッチング装置	7	9	2.3	4	10	0	2.5	13	4	5	0	0	57
12 化合物半導体エッチング装置	0	3	5	0.5	0	1	29	7	2	7.1	3	1	59
13 簡易プラズマ処理装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 酸ドラフト	0	0	0	0	0	0	17	28.5	31	56	5	10	146
15 熱処理炉	13	3	12	4	1	0	4.5	1.5	6	4.5	0	0	49
16 急速アニール炉	4	1.5	8	5	9	6	1.5	1	5	4	8	1	54
17 小型拡散炉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 電界放出型高分解能走査電子顕微鏡	30	25	30	60	39	46	37	53.7	68	49	23.8	23	483
19 段差膜厚計	4.8	19	25	42	38	20	54	33	38	32	9.67	4.5	320
20 レーザー顕微鏡	0	0	0	0	0	0.5	5.3	1	0.5	2.5	0	0	10
21 卓上SEM(EDX)	0	3	1.5	4.5	4.5	24	11	6.5	18	19	0	7.5	99
22 X線光電子分光装置	0	0	6.5	58	42	0	1	0	0	0	0	0	108
23 高精度X線回折装置	124	84	282	215	150	151	240	219	302	446	278	202	2,691





2. 研究室ごとの使用時間と共用率

装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計	管理 使用 時間 研究室	共有 率
	固体 電子 工学 (I)	固体 電子 工学 (II)	電子 機器 工学 (I)	電子 機器 工学 (II)	電子 物性 工学	光 情 報 工 学	光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス	ナ ノ 構 造 科 学	物 性 基 礎 工 学 (I)	グ リ ー ン イ ノ ベ	高 分 子 物 理 学	高 分 子 物 性 工 学			
1 MIKASA アライナ	104	0	0	0	0	0	0	0	0	15.5	0	0	119.5	0	100%
2 両面マスクアライナ	0	0	0	6	0	0	0	0	0	28.67	0	0	34.7	6	83%
3 キャノン アライナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	37.5	0	0	38.5	37.5	3%
4 スプレーコーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 有機ドラフト	128.7	0	0	0	0	0	0	0	0	45.75	0	0	174.4	0.0	100%
6 RFスパッタ装置	4.5	0	462.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.9	4.5	99%
7 電子ビーム蒸着装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.5	0	0	18.5	0	100%
8 LL式電子ビーム蒸着装置	15.5	0	0	0	0	0	0	0	0	62.5	0	0	78	62.5	20%
9 実験用熱蒸着装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 TEOS-CVD装置	79.33	0	0	0	0	0	0	0	0	15.25	0	0	94.6	0	100%
11 Siディープエッチング装置	2	0	0	30.5	0	0	0	4	0	20.25	0	0	56.7	30.5	46%
12 化合物半導体エッチング装置	11	0	0	0	0	0	0	0	0	47.58	0	0	58.583	0	100%
13 簡易プラズマ処理装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 酸ドラフト	94	0	0	0	0	0	0	0	0	52.25	0	0	146.25	0	100%
15 熱処理炉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	49	49	0%
16 急速アニール炉	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	0%
17 小型拡散炉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 電界放出型高分解能走査電子顕微鏡	391.8	0	3.5	0	0	0	81	0	0	6.5	0	0	482.8	0	100%
19 段差膜厚計	19.5	0	7.083	40.08	20.25	0	20	0	0	61.67	150.9	0	319.5	0	100%
20 レーザー顕微鏡	9.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.8	9.75	0%
21 卓上SEM(EDX)	91	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	99.0	0	100%
22 X線光電子分光装置	61.5	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	107.5	46	57%
23 高精度X線回折装置	2467	0	99	56.5	0	0	0	0	0	68.75	0	0	2691.4	99	96%
研究室別使用時間合計	3535	0	573	133.1	66.25	0	108	4	0	529.7	150.9	0	221.72	17.34	92%

